

## THYRISTOR HIGH POWER MODULES VÝKONOVÉ MODULY TYRISTOROVÉ



- ▶ Phase control thyristors couple.
- ▶ Insulated base - 100% tested 2.5 kV (RMS)/60s.
- ▶ Metal pressure contact.
- ▶ Used as controlled line frequency bridge arm.
- ▶ Dvojice síťových tyristorů.
- ▶ Izolovaná základna - 100% testování 2.5 kV (RMS) /60 s.
- ▶ Konstrukce s přítlačným kontaktem.
- ▶ Vhodné jako větev řízeného můstku pro síťové frekvence.

$T_{jmin} = -40\text{ °C}$ ,  $T_{jmax} = 125\text{ °C}$

Replace XX in the device code by the required voltage class ( $V_{DRM}$ ,  $V_{RRM}/100$ ). The voltage range is divided into classes in 200 V steps.  
XX v kódu součástky nahradte požadovanou napěťovou třídou ( $V_{DRM}$ ,  $V_{RRM}/100$ ). Napěťový rozsah je dělen do tříd po 200 V.

Type Typ	$V_{RRM}$ $V_{DRM}$	$I_{TAVm}$ ( $T_c=70\text{ °C}$ )	$I_{TSM}$ ( $T_{jmax}$ , 10ms)	$V_{TO}$ ( $T_{jmax}$ )	$r_T$ ( $T_{jmax}$ )	$V_{TM}/I_{TM}$ ( $T_j=25\text{ °C}$ )	$V_{GT}/I_{GT}$ ( $T_j=25\text{ °C}$ )	$(dvo/dt)_{cr}$ ( $T_{jmax}$ , 50Hz)	$(dir/dt)_{cr}$ ( $T_{jmax}$ , 50Hz)	$t_q^{1)}$ ( $T_{jmax}$ )	$R_{thjc}$	Case Pouzdro
	[V]	[A]	[kA]	[V]	[mΩ]	[V/A]	[V/mA]	[V/μs]	[A/μs]	[μs]	[K/W]	
MTT 431-63-XX	1000-1600	67	1.1	0.9	3.80	1.6/200	3/200	1000	100	150	0.50	431
MTT 431-80-XX	1000-1600	74	1.3	0.84	3.30	1.45/200	3/200	1000	100	150	0.48	431
MTT 442-160-XX	1000-1600	156	3.6	0.84	1.33	1.45/500	2/200	1000	100	160	0.23	442
MTT 452-200-XX	1000-1600	205	4.5	1	1.20	1.8/630	3/300	1000	100, 200	160	0.15	442
MTT 452-250-XX	1000-1600	290	5	0.91	0.75	1.55/785	3/300	1000	100, 200	160	0.12	442

1) typical value / typická hodnota

The above listed parameters are also valid for the appropriate device of combined modules MTD or MDT.  
Uvedené parametry platí i pro příslušnou součástku kombinovaného modulu MTD nebo MDT.

## FAST THYRISTOR HIGH POWER MODULES VÝKONOVÉ MODULY S RYCHLÝMI TYRISTORY

- ▶ Fast thyristors couple.
- ▶ Insulated base - 100% tested 2.5 kV (RMS) / 60 s.
- ▶ Metal pressure contact.
- ▶ Used as controlled bridge arm.
- ▶ Dvojice rychlých tyristorů.
- ▶ Izolovaná základna - 100% testování 2.5 kV (RMS) / 60 s.
- ▶ Konstrukce s přítlačným kontaktem.
- ▶ Vhodné jako větev řízeného můstku.

$T_{jmin} = -40\text{ °C}$ ,  $T_{jmax} = 125\text{ °C}$

Replace XX in the device code by the required voltage class ( $V_{DRM}$ ,  $V_{RRM}/100$ ). The voltage range is divided into classes in 200 V steps.  
XX v kódu součástky nahradte požadovanou napěťovou třídou ( $V_{DRM}$ ,  $V_{RRM}/100$ ). Napěťový rozsah je dělen do tříd po 200 V.

Type Typ	$V_{RRM}$ $V_{DRM}$	$I_{TAVm}$ ( $T_c=70\text{ °C}$ )	$I_{TSM}$ ( $T_{jmax}$ , 10ms)	$V_{TO}$ ( $T_{jmax}$ )	$r_T$ ( $T_{jmax}$ )	$V_{TM}/I_{TM}$ ( $T_{jmax}$ )	$V_{GT}/I_{GT}$ ( $T_j=25\text{ °C}$ )	$(dvo/dt)_{cr}$ ( $T_{jmax}$ , 50Hz)	$(dir/dt)_{cr}$ ( $T_{jmax}$ , 50Hz)	$t_q$ ( $T_{jmax}$ )	$R_{thjc}$	Case Pouzdro
	[V]	[A]	[kA]	[V]	[mΩ]	[V/A]	[V/mA]	[V/μs]	[A/μs]	[μs]	[K/W]	
MTT 431R-63-XX	1000-1200	55	1.4	1.67	2.70	2.2/200	2.5/400	1000	100	25, 32	0.48	431
MTT 442R-100-XX	1000-1200	110	2.6	2.28	0.40	2.37/300	2.5/400	1000	200	16, 20	0.20	442
MTT 442R-125-XX	1000-1200	140	3.5	1.48	1.12	1.96/400	2.5/400	1000	200	25, 32	0.20	442

The above listed parameters are also valid for the appropriate device of combined modules MTD or MDT.  
Uvedené parametry platí i pro příslušnou součástku kombinovaného modulu MTD nebo MDT.